右手/左手系複合メタマテリアルの基礎と回路設計

真田篤志

山口大学大学院理工学研究科

〒755-8611 宇部市常盤台 2-16-1

Tel: +81-836-85-9805, Fax: +81-836-85-9801, sanada@ieee.org

概要

右手/左手系複合(CRLH)メタマテリアルの設計に必要な媒質構成理論と回路 設計の考え方を概説する.まず,左手系媒質の諸性質を示した後,媒質設計の基 礎となる伝送線路理論と周期構造線路についてまとめる.次に CRLH 媒質の構成 理論を示し,媒質中の波の分散特性および特性インピーダンスを理論的に示す. さらに,回路設計で実用上重要となるバランス型 CRLH 媒質の概念とその性質を 示す.

1. はじめに

メタマテリアルは,波長に比べて十分小さい 材料小片を単位粒子としてこれを並べて構成し た構造体である.メタマテリアルは,その波長 の波に対しては実効的に均質な媒質として扱う ことができ,その実効的な電気的・磁気的性質 は,単位粒子の種類,形状および配列により決 まる.近年,自然にはない特異な性質を持つメ タマテリアルの構成法が提案されてきている.

左手系媒質[1]は、誘電率と透磁率とが共に負 となる媒質である. 左手系媒質は、屈折率が負 となり、エバネセント波が増大したりするなど 特異な性質を持つことが知られている. 現在の 所、自然に存在する左手系媒質は見つかってい ないが、メタマテリアルの概念を用いて構成可 能であることが実証されている[2]. 当初の左手 系媒質はスプリットリング共振器(SRR)[3]とワ イヤ共振器[4]とを組み合わせて構成されたが、 動作帯域が狭く、損失も大きいものであった. その後、伝送線路理論に基づく非共振型の左手 系媒質の構成法が提案され[5-7]、その広帯域動 作かつ低損失動作のため工学的にも左手系媒質 の電磁波応用[8-11]が期待されるようになって きた.

右手/左手系複合 (composite right/lefthanded; CRLH) 媒質の構成の概念[12-15]は,非 共振型の左手系媒質の構成法の最も基礎的なも のであり, CRLH 媒質モデルを用いると,左手 系および右手系の波の伝搬,バンドギャップの 存在など,現実的な左手系媒質の性質を非常に 良く表すことができる.しかし, CRLH 媒質の 媒質設計法に関する基礎的な文献はまだ少ない ようである.

本稿では, CRLH 媒質の理論とその性質について概説する.まず, 左手系媒質の一般的な性

質について述べた後, CRLH メタマテリアル媒 質構成理論の基となる伝送線路理論および周期 構造線路理論について簡単にまとめる.次に CRLH 媒質モデルを,右手系線路モデルおよび 理想左手系線路モデルと比較しながら示し, CRLH 媒質中を伝搬する波の分散関係およびブ ロッホインピーダンスを理論的に求め,基本伝 送特性を明らかにする.また媒質設計に重要な バランス型 CRLH 媒質の概念を示し,これが回 路設計に極めて有利となることを示す.

2. 左手系媒質

一般に, 媒質を誘電率および透磁率の符号に より分類すると図 1 の様になる. 左手系媒質は 誘電率 ϵ および透磁率 μ が同時に負となる媒質 [1]で, 図では第 3 象限に配される. この媒質中 を伝搬する平面波の電界 E, 磁界 H および波数 ベクトル kの関係は, Maxwell 方程式[16,17]に従 い,

$$\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E} = \boldsymbol{\omega} \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{H} \tag{1}$$

$$\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{H} = -\boldsymbol{\omega} \boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{E} \tag{2}$$

μ,	N N		
<i>ɛ</i> -negative materials	Right-handed materials		
$\varepsilon < 0, \mu > 0$	$\varepsilon > 0, \ \mu > 0$		
$\gamma \in \mathfrak{R}$: evanescent	$\gamma \in \mathfrak{I}$: propagation		
Left-handed materials $\varepsilon < 0, \ \mu < 0$	μ -negative ε materials $\varepsilon > 0, \ \mu < 0$		
$\gamma \in \mathfrak{I}$: propagation	$\gamma \in \mathfrak{R}$: evanescent		

図1 媒質の*ε*, μによる分類.



図2 媒質中の*E*, *H*, *k*の関係.

で表される. ここで ω は角周波数である. ε<0 および μ<0 である左手系媒質中で E, H およ び k は図2の様に左手系をなす.

この場合波数ベクトルkはポインティングベ クトル $s=E \times H$ と反平行となる.このことは, 位相とエネルギーの伝搬方向が互いに逆となる バックワード波が伝搬することを示している.

左手系媒質の特徴を示しておこう.まず,左 手系媒質の屈折率 n は,因果律から負の値をと らなければならない[1].

$$n = -\sqrt{\epsilon \mu} \tag{3}$$

また,左手系媒質は必然的に分散性を持たな ければならない.左手系媒質中の電気エネルギ ーおよび磁気エネルギーはそれぞれ、

$$W_{\rm e} = \frac{\partial(\omega\varepsilon)}{\partial\omega} |\boldsymbol{E}|^2 \tag{4}$$

$$W_{\rm m} = \frac{\partial(\omega\mu)}{\partial\omega} \left| \boldsymbol{H} \right|^2 \tag{5}$$

で与えられるが、両者は共に正であることから 式(4)および(5)式の右辺の係数が正でなければ ならない.したがって、左手系媒質中では、 ε お よび μ は周波数の関数とならなければならない [1].

さらに, 左手系媒質中ではエバネセント波は 増大する. 左手系媒質中の波の波数 k を, 伝搬 に垂直な横方向の波数 k₁で表すと,

$$\left|\boldsymbol{k}\right| = j\sqrt{\left|\boldsymbol{k}_{\perp}\right|^{2} - \boldsymbol{\varepsilon}\boldsymbol{\mu}\left|\boldsymbol{k}_{0}\right|^{2}} \tag{6}$$

となる. ここで k_0 は真空中の波数である. $|k_{\perp}|^2 > qu |k_0|^2$ なるエバネセント波に対して, 伝搬 方向を z 軸にとれば伝搬因子は exp(-jkz) = $exp(+\alpha z)$ となるため, エバネセント波は伝搬に 伴いその大きさが指数関数的に増大する[18].

3. 伝送線路理論と周期構造線路

3.1 伝送線路理論

図 3(a)の様な一様な分布定数線路中の微小区 間Δz を,図 3(b)の様な単位長さ当たりの直列イン ピーダンスZ'(Ω/m)および単位長さ当たりの並列ア ドミタンス Y'(S/m) で表す.図3は伝送線路モデ ルと呼ばれる[19,20].

いま, △z→0の極限を考えると、線路を伝搬する



図 3 伝送線路モデル. (a) 一様分布定数線路.
 (b) 微小区間回路モデル (Δz→0).



図4 周期構造線路.(a)1次元周期構造線路.(b)単位セル(1次元). (c)単位セル(2次元).

角振動数 ω の波動の伝搬定数 γ および特性インピーダンス Z_0 は、

$$\gamma = \sqrt{Z'Y'} \tag{7}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{Z'}{Y'}} \tag{8}$$

で表される.

式(7)および(8)を, 誘電率 ε, 透磁率 μなる均質 媒質中の波動方程式と比較すれば,

$$\varepsilon = \frac{1}{j\omega} \frac{\gamma}{Z_0} = \frac{Y'}{j\omega} \tag{9}$$

$$\mu = \frac{1}{j\omega} \gamma Z_0 = \frac{Z'}{j\omega} \tag{10}$$

と対応づけられる.

3.2 周期構造線路

周期構造中を伝搬する波は、固体結晶中の弾 性波からの類推によりブロッホ波と呼ばれる.ブロッ ホ波の分散特性およびインピーダンスは周期性の 影響を強く受ける[20].

いま,図4(a)の周期構造線路に対する単位セル を,図4(b)の様に表す.各端子における電圧およ び電流の関係をF行列で表すと次の様になる.

$$\begin{bmatrix} V_n \\ I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{n+1} \\ I_{n+1} \end{bmatrix}$$
(11)

各端子における電圧波および電流波は,ブロッホ・フロケの定理[17,19,21]により

$$\begin{bmatrix} V_n \\ I_n \end{bmatrix} = e^{\gamma a} \begin{bmatrix} V_{n+1} \\ I_{n+1} \end{bmatrix}$$
(12)

と書ける. この関係を式(11)に与えることで,

$$\begin{bmatrix} A - e^{\gamma a} & B \\ C & D - e^{\gamma a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{n+1} \\ I_{n+1} \end{bmatrix} = 0$$
(13)

を得る.上式の V_{n+1} , I_{n+1} が自明でない解を持つには、左辺の行列の行列式が零でなければならない.これに、回路が可逆である場合にはAD-BC=1であることを考慮すると、

$$\cosh \gamma a = \frac{A+D}{2} \tag{14}$$

を得る.これが分散関係を与える.

ブロッホ波に対するインピーダンスは,端子面に おける電圧と電流の比をとると次式で与えられる.

$$Z_{\rm B}^{\pm} = \frac{-2B}{A - D \mp \sqrt{(A + D)^2 - 4}}$$
(15)

これはブロッホインピーダンスと呼ばれる[20]. Z_B の 複号は z 軸の正または負に伝搬する波に対するも のである. Z_B は周期的に変化し、一意的には決ま らないことにも注意が必要である.

なお,単位セルが対称の場合,*A* = *D* となるため 分散関係式およびブロッホインピーダンスは

$$\cosh \gamma a = A$$
 (16)

$$Z_{\rm B}^{\pm} = \pm \sqrt{\frac{B}{C}} \tag{17}$$

と簡略化される.

3.3 多次元周期構造線路

2 次元以上の周期構造に対しては一般的には 伝送行列を書き表さないが、例えば、2次元周期構 造に対して、図 3(c)の様に xy 面上の回路の各端 子上で電圧・電流を定義し、これらの関係を

$$\begin{bmatrix} V_n^x \\ I_n^x \\ V_n^y \\ I_n^y \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} V_{n+1}^x \\ I_{n+1}^x \\ V_{n+1}^y \\ I_{n+1}^y \end{bmatrix}$$
(18)



図 5 単位セルモデル.(a) 右手系線路.(b) 理想左 手系線路.(c) 右手/左手系複合線路.

と書き表すと、1次元周期構造と同様な手法により 分散関係を、

$$\det \left(A - \operatorname{diag} \left[e^{jk_x a}, e^{jk_x a}, e^{jk_y b}, e^{jk_y b} \right] \right) = 0$$
(19)

により求めることができる. ここで k_x および k_y はそれ ぞれ x 方向および y 方向の波数, a および b は x方向および y 方向の周期である.

3 次元線路に対しても同様にして分散関係を求 めることができる.

4. 左手系媒質の伝送線路モデル

4.1 理想左手系線路

まず,通常の右手系の分布定数線路の分散関係 と特性インピーダンスをまとめておく.図 5(a)は, 右手系の分布定数線路モデルである[19,20].ここ で簡単のため線路は無損失であると仮定してい る.この線路の伝搬定数 $\beta = -j\gamma$ および特性インピ ーダンスは,式(7)および(8)において $Z' = j\omega L'$ およ び $Y' = j\omega C'$ とすることで、

$$\beta = \omega \sqrt{L'C'} \tag{20}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \tag{21}$$

と得られる. ここで L' および C' はそれぞれ単位 長さ当たりのインダクタンスおよびキャパシタンスで, 単位は H/m および F/m である. なお, 位相速度 および群速度は,

$$v_{\rm p} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L'C'}} \tag{22}$$

$$v_{\rm g} = \left(\frac{\partial \beta}{\partial \omega}\right)^{-1} = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}$$
(23)

となり、符号および大きさは等しい.

一方,図 4(a)の直列インダクタンスと並列キャパ シタンスとを入れ替えた図 4(b)の様な双対回路を 考える[22]. この回路は理想左手系線路と呼ばれ る. この回路は、フィルタ理論において高域通過 特性を持つ回路[23]としても古くから知られている ものであることは興味深い. この回路を伝送線路と して考えた場合の分散関係およびインピーダンス



は、式(7)および(8)において $Z' = 1/(j\omega C')$ および Y' = $1/(j\omega L')$ とし、エネルギーが z 軸の正の方向 に伝搬する波の因果律を考慮すると、

$$\beta = -\frac{1}{\omega\sqrt{L'C'}} \tag{24}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \tag{25}$$

と得られる. ここで C'および L'の単位はそれぞれ F·m および H·m でなければならないことに注意が 必要である.

理想左手系線路の特性インピーダンスは,式 (25)の様に L' と C' の比の平方根で決まる.これ は式(21)の右手系線路の場合と同じである.このこ とから,双対な右手系線路と左手系線路同士は自 動的に整合することになる.

式(24)の伝搬定数βから、位相速度および群速 度はそれぞれ、

$$v_{\rm p} = \frac{\omega}{\beta} = -\omega^2 \sqrt{L'C'}$$
(26)

$$v_{\rm g} = \left(\frac{\partial\beta}{\partial\omega}\right)^{-1} = \omega^2 \sqrt{L'C'} \tag{27}$$

と求められる.両者の符号は異なりこの線路を伝搬 する波はバックワード波であることがわかる.

図 5(b)の理想左手系線路モデルは非常に明解 で左手系媒質の動作を直感的に説明することがで きるが、現実の物理現象を良く表さない側面もある. 例えば、各素子値 $C'/\Delta z \ge L'/\Delta z$ を有限値に保った まま $\Delta z \rightarrow 0$ とすることは現実的ではない.また、式 (27)によれば群速度 v_g は角周波数 ω が大きくなる につれていくらでも増加し、やがて光速を越えてし まう. この矛盾は、単位セル中のホスト媒質の寄生 の右手系の影響、すなわち単位長さ当たりの直列 インダクタンスと単位長さ当たりの並列容量を無視 したために生じたものである. 現実の左手系媒質 を取り扱うにはこれらを考慮しなければならない. こ のため後述の CRLH 線路が提案されている [12-15].

右手系線路と理想左手系線路,さらに次節で述 べる CRLH 線路の分散特性と特性インピーダンス をまとめて表1に示しておく.

4.2 右手/左手系複合(CRLH)線路

右手/左手系複合(composite right/left-handed; CRLH)線路モデルを図 5(c)に示す.ここでは、左 手系の直列の容量 $C'_{1/a}$ および並列のインダクタン ス $L'_{1/a}$ に加えて、右手系の寄生の直列インダクタ ンス L'_{Ra} および並列キャパシタンス C'_{Ra} が導入さ れている. CRLH 線路モデルは、物理現象を良く 表す最も一般的な左手系線路モデルのうちの一つ である.

CRLH 線路中の波の伝搬特性を直感的に捉え るために、以下の考察をしておこう. CRLH 線路モ デルにおいて, 直列ブランチは周波数が低い場合 には容量的で、周波数が高い場合には誘導的と なる. 逆に、並列ブランチは周波数が低い場合に は誘導的で、周波数が高い場合には容量的にな る. 従って, 低周波域に左手系伝搬帯域が、また 高周波域に右手系伝送帯域が存在することになる. また, 左手系伝送帯域と右手系伝送帯域との間で 直列および並列ブランチが共に誘導的あるいは共 に容量的となる場合がある. この帯域ではバンドギ ャップが生じる.なお、単位セルの周期 a が有限な 場合には、 左手系伝送帯域の低域側に、 また右 手系伝送帯域の高域側にそれぞれカットオフ周波 数を持つ. これは図 5(c)の回路がバンドパス特性 を持つことによるものである. この様な CRLH 線路 の伝搬域と周波数の関係を表2にまとめておく.

				
Evanescent	Propagation	Evanescent	Propagation	Evanescent
High-pass cut-off	LH	Bandgap	RH	Low-pass cut-off
Bragg (LH)	ε<0, μ<0	$\varepsilon < 0, \ \mu > 0$ or $\varepsilon < 0, \ \mu < 0$	ε>0, μ>0	Bragg (RH)



図 6 2 次元 CRLH 媒質の単位セルモデル.

5. CRLH メタマテリアルの基本伝送特性

ここでは 2 次元の CRLH 線路モデルを取り上げ て, CRLH メタマテリアル中の波動の伝搬特性を示 そう.

まず,前節の CRLH 線路モデルを図6の様に2 次元に拡張する.本モデルは x 方向に伝搬する CRLH 線路モデルにそれに直交する y 方向のブラ ンチを付加したもので, xy 面内に伝搬する2次元の 波の伝搬を表すことができる.ここで簡単のため, 単位セルは x, y 方向共に周期が a で対称とし,各 ブランチの素子値を,

$$C_{\rm L} = C'_{\rm L} / a, \quad L_{\rm L} = L'_{\rm L} / a$$
 (28)

$$C_{\rm R} = C'_{\rm R}a, \quad L_{\rm R} = L'_{\rm R}a \tag{29}$$

とする.

1次元の線路の解析と同様に、各ノードにおける 電圧および各ノードをxあるいはyの正の方向に流 れる電流を定義する.式(19)より分散関係式は次 式の様に求められる[12].

$$\frac{\left(e^{-jk_xa}-1\right)^2}{e^{-jk_xa}} + \frac{\left(e^{-jk_ya}-1\right)^2}{e^{-jk_ya}} - 2Z(\omega)Y(\omega) = 0$$
(30)



図 7 2 次元 CRLH 媒質の分散特性. 太線はバランス型 ($\omega_{se} = \omega_{sh}$) $C_L = C_R = 1.0 \text{ pF}$, $L_L = L_R = 1.0 \text{ nH}$; 細線はアンバ ランス型 ($\omega_{se} \neq \omega_{sh}$) $C_L = 2.0 \text{ pF}$, $C_R = 1.0 \text{ pF}$, $L_L = L_R = 1.0 \text{ nH}$.

ここで Z(ω)および Y(ω)はそれぞれ直列ブランチの インピーダンスおよび並列ブランチのアドミタンスで あり、

$$Z(\omega) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{j \omega C_{\rm L}} + j \omega L_{\rm R} \right)$$
(31)

$$Y(\omega) = \frac{1}{j\omega L_{\rm L}} + j\omega C_{\rm R} \tag{32}$$

となる. なお伝搬定数βの大きさは次式で与えられる.

$$\beta = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} \tag{33}$$

式(30)より群速度を求めると,

$$v_{\rm g} = \frac{\partial \omega}{\partial \beta} = -\frac{a \sin \beta a}{\frac{1}{\omega^3 L_{\rm I} C_{\rm I}} - \omega L_{\rm R} C_{\rm R}}$$
(34)

となる. これより,

$$v_{\rm g} < \frac{1}{\sqrt{L'_{\rm R}C'_{\rm R}}} < \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = c_0$$
 (35)

を示すことができる. ここで c₀ は光速である. すなわち CRLH 媒質中では群速度は光速を超えない.

式(30)で与えられる典型的な分散特性を図 7 に 示す.ここで横軸の Γ , X, Mはブリルアンゾーン[21] 上の高対称点であり, Γ 点は(k_x , k_y)の波数空間上 の点(0, 0)を, X 点は点(π/a , 0)を, また M 点は点 (π/a , π/a)を表している. すなわち Γ -X の領域では, $k_y = 0$ としたまま k_x が 0 から π/a と変化する場合を, X-Mの領域では $k_x = \pi/a$ としたまま k_y が 0 から π/a に変化する場合を, また M-Iの領域では $k_x = k_y$ と して π/a から0に変化する場合の波の伝搬をそれぞ れ表している. Γ -Xの領域では,単位セルの辺に平 行な方向に伝搬する波の分散関係を, M- Γ の領域 では単位セルの対角方向に伝搬する波の分散関 係を表すことになる.なお, Γ -Xの軸とM- Γ の軸とで は波数の大小関係が逆となっていることに注意が 必要である.

図中の太線は $C_L = C_R = 1.0$ pF, $L_L = L_R = 1.0$ nHとした場合で、細線は $C_L = 2.0$ pF, $C_R = 1.0$ pF, $L_{\rm L} = L_{\rm R} = 1.0$ nH とした場合である. これらの違い の詳細については後述するが、典型的な2種類の 分散特性を示している. 分散特性の傾きは群速度 を、原点からの直線の傾きは位相速度を表す[16] ため、図よりΓ-X 領域において角周波数がωπから ω_{Γ} の範囲では Γ, X 点上を除いて群速度が負でか つ位相速度は正と異符号となっていることがわかる. したがって図の角周波数*ω*_{XL}から*ω*_Πの範囲では バックワード波が伝搬することになる. なお M-F領 域においても、軸の正負がΓ-X 領域と比べて反転 していることを考慮すればバックワード波が伝搬す ることがわかる. 逆に, 角周波数が ωx から ωR の 範囲では群速度と位相速度の符号が等しく、右手 系の波の伝搬である. 一般には細線の場合の様 に左手系伝搬帯域の上限角周波数ωπ と右手系 伝搬帯域の下限角周波数*ω*_Rの間にはバンドギャ ップが存在する.

図中の各点の周波数を求めておこう. これらは, 式(30)の分散関係式にΓ, Xおよび M 点の波数(k_x, k_v)を代入することで次式のように求められる[13].

$$\omega_{\rm TL} = \min(\omega_{\rm se}, \omega_{\rm sh}) \tag{36}$$

$$\omega_{IR} = \max(\omega_{se}, \omega_{sh}) \tag{37}$$



図 8 ブロッホインピーダンス. 太線はバランス型の場 合($\omega_{se} = \omega_{sh}$)で $C_L = C_R = 1.0$ pF, $L_L = L_R = 1.0$ nH; 細線は アンバランス型 ($\omega_{se} \neq \omega_{sh}$) $C_L = 2.0$ pF, $C_R = 1.0$ pF, $L_L = L_R = 1.0$ nH.

$$\begin{array}{l}
\left. \omega_{XL}^{2} \\
\left. \omega_{XR}^{2} \right\} = \frac{\omega_{se}^{2} + \omega_{sh}^{2}}{2} + 2\omega_{R}^{2} \mp \left\{ \left(\frac{\omega_{se}^{2} + \omega_{sh}^{2}}{2} + 2\omega_{R}^{2} \right)^{2} - \omega_{se}^{2} \omega_{sh}^{2} \right\}^{\frac{1}{2}} \\
\left. (38) \\
\left. \omega_{MR}^{2} \right\} = \frac{\omega_{se}^{2} + \omega_{sh}^{2}}{2} + 4\omega_{R}^{2} \mp \left\{ \left(\frac{\omega_{se}^{2} + \omega_{sh}^{2}}{2} + 4\omega_{R}^{2} \right)^{2} - \omega_{se}^{2} \omega_{sh}^{2} \right\}^{\frac{1}{2}} \\
\left. (39) \\
\left. (39) \right\}$$

ここで $\omega_{\rm L}, \omega_{\rm R}, \omega_{\rm se}$ および $\omega_{\rm sh}$ は

$$\omega_{\rm L} = \frac{1}{\sqrt{L_{\rm L}C_{\rm L}}}, \quad \omega_{\rm R} = \frac{1}{\sqrt{L_{\rm R}C_{\rm R}}}$$
$$\omega_{\rm se} = \frac{1}{\sqrt{L_{\rm R}C_{\rm L}}}, \quad \omega_{\rm sh} = \frac{1}{\sqrt{L_{\rm L}C_{\rm R}}}$$

である.

*ω*se および*ω*sh は物理的には図 6 の CRLH 単位 セルの直列ブランチの共振角周波数と並列ブラン チの共振角周波数を表す.式(36)および(37)によ るとバンドギャップは CRLH 単位セルの直列ブラン チと並列ブランチの共振角周波数により決まること は興味深い.この*ω*se と*ω*sh の大小関係によりこのバ ンドギャップが誘導的であるか容量的であるかが決 まる.

Γ点に近い領域ではβ~0であるので波長は単位 セル周期に比べて十分長く、均質媒質近似が成り 立つ.このため合理的に実効屈折率を定義するこ とができる.左手系および右手系伝送帯域におい て実効屈折率を求めるとそれぞれ次式の様になる.

$$n = \frac{c_0 \beta}{\omega}$$

$$= \begin{cases} -\frac{c_0}{\omega a} \cos^{-1} \left\{ 1 - \frac{1}{2} \left[\frac{\omega_L^2}{\omega^2} + \frac{\omega^2}{\omega_R^2} - \left(\frac{\omega_{sh}^2}{\omega_R^2} + \frac{\omega_{se}^2}{\omega_R^2} \right) \right] \right\} \\ \text{LH (where } \omega \approx \omega_{\Gamma1}) \\ \frac{c_0}{\omega a} \cos^{-1} \left\{ 1 - \frac{1}{2} \left[\frac{\omega_L^2}{\omega^2} + \frac{\omega^2}{\omega_R^2} + \left(\frac{\omega_{sh}^2}{\omega_R^2} + \frac{\omega_{se}^2}{\omega_R^2} \right) \right] \right\} \\ \text{RH (where } \omega \approx \omega_{\Gamma2}) \end{cases}$$
(40)

最後にブロッホインピーダンスを求めておこう. 簡 単のため,図6の単位セルに対してx方向に伝搬 する波を考える. このときブロッホインピーダンスは 1次元線路を伝搬する波のそれと等しく,式(17)よ り,

$$Z_{\rm B} = Z_{\rm L} \sqrt{\frac{\frac{\omega^2}{\omega_{\rm se}^2} - 1}{\frac{\omega^2}{\omega_{\rm sh}^2} - 1}} - \frac{\omega_{\rm L}^2}{4\omega^2} \left(\frac{\omega^2}{\omega_{\rm se}^2} - 1\right)^2 \qquad (41)$$

と得られる[13]. ここでZLは,

$$Z_{\rm L} = \sqrt{\frac{L_{\rm L}}{C_{\rm L}}} \tag{42}$$

である.

式(41)のブロッホインピーダンスを図示すると図 8 の様になる. ここでは, 典型的な素子値として C_L = C_R = 1.0 pF, $L_L = L_R$ = 1.0 nH の場合(太線)と, C_L = 2.0 pF, C_R = 1.0 pF, $L_L = L_R$ = 1.0 nH の場合(細 線)の2 種類を示した. 図の様に, ブロッホインピー ダンスはパラメータの違いにもよるが零から無限大 まで変化する. しかし後述するように帯域内で緩や かな変化となるように設計することも可能である.

6. バランス型 CRLH メタマテリアル

いま特別な場合として,図6の単位セルの直列 ブランチの共振回路と並列ブランチの共振回路の 共振角周波数が等しい場合,すなわち,

$$\omega_{\rm se} = \omega_{\rm sh} \tag{43}$$

なる場合を考える. この条件は CRLH メタマテリア ルのバランス条件[12]と呼ばれる. バランス条件下 で媒質中の波の伝搬特性は特徴的となり応用上も 重要である. この時の特に重要な波の伝搬の様子 をまとめておこう.

バンドギャップの消失

式(36)および(37)より, ω_{se} および ω_{sh} は、バンドギャップの上限および下限の角周波数となる. CRLH 媒質がバランス条件を満足しこれらが一致する場合, $\omega_{se} = \omega_{sh} \equiv \omega_{\Gamma}$ においてバンドギャップは閉じて消失することになる. このとき, 左手系伝送帯域 と右手系伝送帯域は*の*れにおいてシームレスに繋がることになる.このことは漏洩波アンテナなど,バックワード波とフォワード波の双方を利用する場合の 媒質設計には特に重要である.

Г点におけるエネルギーの伝送

CRLH 媒質がバランス条件を満足する場合の Γ 点におけるエネルギーの伝送を考えよう. いま簡 単のため x 方向に伝搬する波を考える. 式(34)に おいて $\omega \rightarrow \omega_{\Gamma}$ ($\beta \rightarrow 0$)なる極限を考えると分母と 分子共に零となり不定となるが, ベルヌイ-ロピタル の定理を使うと.

$$\frac{\partial \omega}{\partial \beta} \stackrel{(\omega \to \omega_{\rm r})}{=} - \frac{a^2 (\cos \beta a) \left(\frac{\partial \omega}{\partial \beta}\right)^{-1}}{-\frac{3}{\omega^4 L_L C_L} - L_R C_R}$$

$$= \frac{a^2 \left(\frac{\partial \omega}{\partial \beta}\right)^{-1}}{\frac{3L_L C_L L_R C_R}{L_L C_L} + L_R C_R} = \frac{a^2}{4L_R C_R} \left(\frac{\partial \omega}{\partial \beta}\right)^{-1}$$
(44)

なる関係を得る[12]. これを(∂ω/∂β)について整理 することで,

$$\left|\frac{\partial\omega}{\partial\beta}\right|_{\omega=\omega_{r}} = \sqrt{\frac{a^{2}}{4L_{R}C_{R}}} = \frac{1}{2\sqrt{L'_{R}C'_{R}}}$$
(45)

を得る.

図7の太線はバランス型の場合の分散特性を示したものである. Г点においてバンドギャップが消失しているが、「点における分散曲線の傾きすなわち群速度に注目すると、傾きは非零の有限な値となりエネルギーの伝送が可能であることがわかる. これに対して、細線のアンバランス型の場合には「点において傾きが零となりエネルギーの伝送はない.

なお、バランス型 CRLH 媒質のホスト媒質が真空であるとすると式 (45) は $1/(2\sqrt{L_{R}C_{R}})=1/(2\sqrt{\varepsilon_{0}\mu_{0}})=c_{0}/2$ と光速の丁度半分となることは興味深い[12].

Г点におけるブロッホインピーダンスの連続性

式(41)によるとブロッホインピーダンス Z_B は $\omega \rightarrow \omega_{se}$ で零に, $\omega \rightarrow \omega_{se}$ で無限大にそれぞれ漸 近する. それではバランス型の場合にはどうであろ うか. 式(41)で $\omega \rightarrow \omega_{se} = \omega_{sh}$ とすれば Z_B は,

$$Z_{\rm B} = Z_{\rm I} \tag{46}$$

となり非零の有限の値をとることになる[13].

図8の太線はバランス型の場合のZ_Bの周波数変化である. 細線のアンバランス型の場合にはバ

ンドギャップの上限および下限周波数においてインピーダンスが零と無限大にそれぞれ変化し、その前後の周波数においてZ_Bが大きく変化している.これに対して、バランス型の場合には、バランス周波数においてZ_BはZ_Lの値となり、その前後での変化も小さくなっていることがわかる.このことは、バランス周波数付近で左手系伝送帯域と右手系伝送帯域の双方に整合が可能であることを示しており、応用上非常に重要である.

6. まとめ

非共振型の左手系媒質として最も一般的な, CRLH 媒質の概念と性質について示した.多く のCRLHメタマテリアル設計においてバランス 条件を満足させる設計は必須となるであろう. 本稿がCRLH媒質による新たなデバイス設計概 念構築の一助となれば幸いである.

References

[1] V. G. Veselago, "The electrodynamics of substances with simultaneously negative values of ε and μ " Soviet Physics Uspekhi, vol. 10, No. 4, pp.509-514, Jan-Feb., 1968.

[2] D. R. Smith, W. J. Padilla, D. C. Vier, S. C. Nemat-Nasser, and S. Schultz, "Composite medium with simultaneously negative permeability and permittivity," Phys. Rev. Lett., vol. 84, no. 18, pp.4184-4187, May 2000.

[3] J. B. Pendry, A. J. Holden, D. J. Robins, and W. J. Stewart, "Magnetism from conductors and enhanced nonlinear phenomena," IEEE Trans. on Microwave Theory and Tech., vol. 47, no. 11, pp. 2075-2084, 1999.

[4] J. B. Pendry, A. J. Holden, D. J. Robbins, and W. J. Stewart, "Low frequency plasomosin thin-wire structures," J. Phys.: Condens. Matter, Vol. 10, pp. 4785-4809, March 1998.

[5] C. Caloz, and T. Itoh, "Application of the transmission line theory of left-handed (LH) materials to the realization of a microstrip LH transmission line", IEEE-APS Int'l Symp. Digest, vol. 2, pp. 412-415, June 2002.

[6] A. A. Oliner, "A periodic-structure negative-refractive-index medium without resonant elements," IEEE-APS/URSI Int'l Symp. Digest, p. 41, June 2002.

[7] A. K. Iyer and G. V. Eleftheriades , "Negative refractive index media using periodically *L-C* loaded Transmission lines," IEEE-MTT Int'l Symp. Digest, pp 1067-1070, June 2002.

[8] C. Caloz and T. Itoh, "Novel microwave devices and structures based on the transmission line approach of meta-materials", IEEE-MTT Int'l Symp. Digest, pp.195-198, June 2003.

[9] A. Grbic and G. V. Eleftheriades, "Experimental verification of backward-wave radiation from a negative refractive index material," Journal of Applied Physics, Vol. 92, No. 10, pp. 5930-5935, Nov. 2002.

[10] C. Caloz, A. Sanada, L. Liu and T. Itoh, "A broadband left-handed (LH) coupled-line backward coupler with arbitrary coupling level," IEEE-MTT Int'l Symp. Digest, pp.317-320, June 2003.

[11] A. Sanada, C. Caloz and T. Itoh, "Novel zeroth-order resonance in composite right/left-handed transmission line resonator," 2003 Asia-Pacific Microwave Conference Proceedings, pp.1588-1591, Nov. 2003.

[12] A. Sanada, C. Caloz, and T. Itoh, "Characteristics of the Composite Right/Left-Handed Transmission Lines," IEEE Microwave and Wireless Components Letters, Vol. 14, No.2, pp. 68-70, February 2004

[13] A. Sanada, C. Caloz and T. Itoh, "Planar distributed structures with negative refractive index," IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, Vol. 52, No. 4, pp. 1252-1263, April 2004.

[14] A. Lai, C. Caloz and T. Itoh, "Composite right/left-handed transmission line metamaterials," IEEE Microwave Magazine, vol. 5, no. 3, pp. 34-50, September 2004

[15] C. Caloz and T. Itoh, "Electromagnetic metamaterials," John Wiley & Sons, New York, 2005.

[16] J. D. Jackson, "Classical electrodynamics, third edition," John Wiley & Sons, New York, 1999.

[17] R. E. Collin, "Field theory of guided waves, second ed.," IEEE Press, 1991.

[18] J. B. Pendry, "Negative Refraction Makes a Perfect Lens," Phys. Rev. Lett., Vol. 85, no. 18, pp. 3966-3969, 30 October 2000.

[19] R. E. Collin, "Foundations for microwave engineering, second ed.," McGraw Hill, 1992.

[20] D. M. Pozar, "Microwave engineering, second ed.," John Wiley & Sons, New York, 1998

[21] C. Kittel, "Introduction to Solid State Physics, 7th ed.," John Wiley & Sons, 1995..

[22] S. Ramo, J. R. Whinnery, T. Van Duzer, "Fields and waves in communication electronics second edition," John Wiley & Sons, pp. 257-258, 1984.

[23] G. L. Matthaei, L. Young, and E. M. T. Jones, "Microwave filters, impedance-matching networks, and coupling structures," Artech House, 1980.